

## 2Т916А

кремниевый биполярный  
эпитаксиально-планарный  
n-p-n транзистор

### Назначение

Сверхвысокочастотный эпитаксиально-планарный мощный транзистор в металлическом корпусе. Предназначен для использования в усилительных схемах, автогенераторах и другой аппаратуре специального назначения.

### Обозначение технических условий

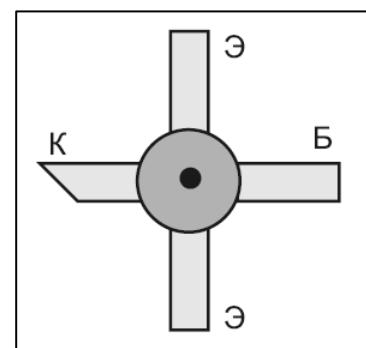
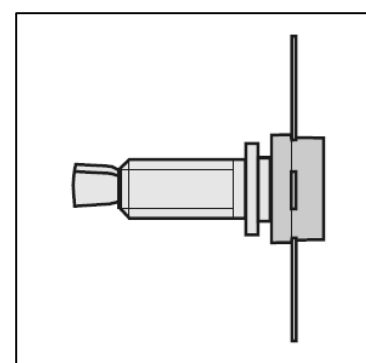
- аАО.339.136ТУ

### Диапазон температур

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 125 °С

### Корпусное исполнение

- корпус КТ-16-2



### Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Коллектор (К)
№2	Эмиттер (Э)
№3	База (Б)
№4	Эмиттер (Э)

**Таблица 1. Основные электрические параметры 2Т916А при  $T_{окр. среды} = + 25\text{ }^{\circ}\text{C}$**

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектор – эмиттер	$I_{кэг}$	мА	$U_{кэ}=55\text{В}$ $R_{эб}=10\text{ Ом}$		25
Емкость коллекторного перехода*	$C_{к*}$	пФ	$U_{кб}=30\text{ В}$ $f=10\text{МГц}$	12	20
Граничная частота коэффициента передачи тока*	$F_{гр*}$	МГц	$U_{кэ}=10\text{В}$ $f=300\text{МГц}$ $I_{к}=1,5\text{А}$	1100	1800
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мА	$U_{эб}=3,5\text{ В}$	5	4000
Напряжение насыщения эмиттер-база	$U_{эб(нас)}$	В	$I_{к}=250\text{мА}$ , $I_{б}=30\text{мА}$	0,8	1
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	$U_{кэ(нас)}$	В	$I_{к}=250\text{мА}$ , $I_{б}=30\text{мА}$	0,1	0,4

\* справочные параметры

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации 2Т916А**

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Значение
Напряжение коллектор-база	$U_{кб\text{ max}}$	В	55
Напряжение коллектор-эмиттер ( $R_{бэ}=10\text{кОм}$ )	$U_{кэ\text{ max}}$	В	55
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб\text{ max}}$	В	3,5
Постоянный ток коллектора	$I_{к\text{ max}}$	мА	2000
Импульсный ток коллектора	$I_{ки\text{ max}}$	А	4
Температура перехода	$T_j$	$^{\circ}\text{C}$	160
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	$P_{к\text{ max}}$	Вт	30